

**Typ tranzystora:** tranzystor krzemowy

**Firma:** TESLA

**Wykonanie:** tranzystor polowy MOS kanał typu N, o dużej rezystancji wejściowej, w obudowie metalowej

**Zastosowanie:** wzmacniacze, przełączające układy impulsowe

**Typy podobne:** 3SK21 (Hit)

Rys. 1-789. KF521

**Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>**

$U_{DS}$	30	20	V	przy $I_D = 10 \mu A$ , $U_{GS} = -6 V$
$-U_T$	3	5	V	przy $I_{DS} = 10 \mu A$ , $U_{DS} = 6 V$
$-I_{GSS}$		4	pA	przy $U_{GS} = -20 V$ , $U_{DS} = 0$
$I_{DSS}$	4 ÷ 10		mA	przy $U_{DS} = 6 V$ , $U_{GS} = 0$
$y_{21e}$	3,5	2,5	mA/V	przy $U_{DS} = 6 V$ , $I_{DS} = 5 mA$ , $f = 1 kHz$
$C_{11e}$	3		pF	przy $U_{DS} = 6 V$ , $U_{GS} = 0$ , $f = 1 MHz$
$r_{DS ON}$	230	300	$\Omega$	przy $U_{DS} = 0,1 V$ , $U_{GS} = 0$
$r_{DS OFF}$	1000	100	M $\Omega$	przy $U_{DS} = 0,1 V$ , $U_{GS} = -6 V$
$U_n$	0,1		$\mu V$	przy $U_{DS} = 6 V$ , $I_{DS} = 5 mA$ , $f = 1 kHz$
$1/g_{11e}$		200	k $\Omega$	} przy $U_{DS} = 6 V$ , $U_{GS} = 0$ , $f = 10 MHz$
$c_{11e}$		2,8	pF	
$1/g_{12e}$		200	k $\Omega$	
$c_{12e}$		0,6	pF	
$1/g_{22e}$		10	k $\Omega$	
$c_{22e}$		2,5	pF	
$1/g_{11e}$		100	k $\Omega$	} przy $U_{DS} = 6 V$ , $U_{GS} = 0$ , $f = 100 MHz$
$c_{11e}$		2,8	pF	
$1/g_{12e}$		100	k $\Omega$	
$c_{12e}$		0,6	pF	
$1/g_{22e}$		6	k $\Omega$	
$c_{22e}$		2,5	pF	

<sup>1)</sup>  $t_{amb} = \sim 25^\circ C$

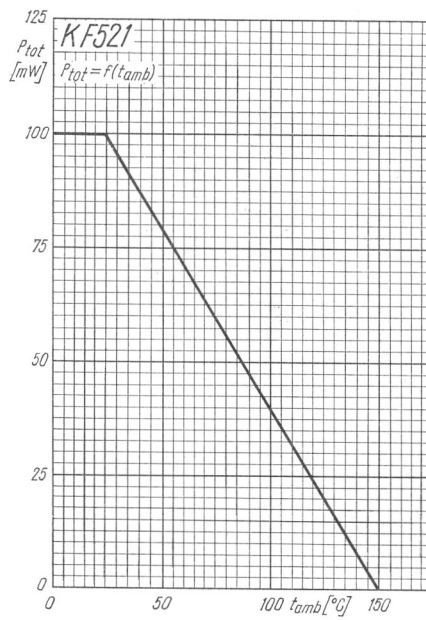
# KF521

## Wartości graniczne<sup>1)</sup>

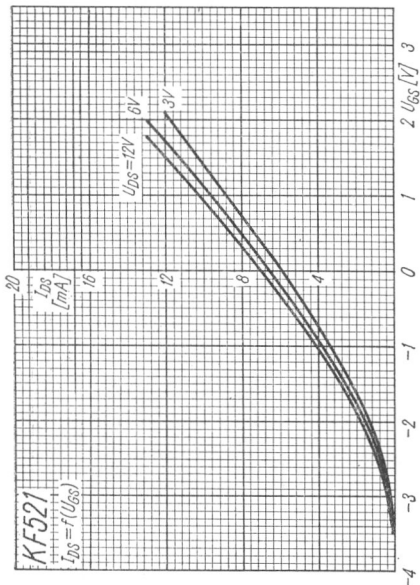
$U_{GSM\ max}$	$\pm 20$	V	$P_{tot\ max}$	100	mW
$U_{DSM}$	20 <sup>2)</sup>	V	$t_{j\ max}$	150	°C
$I_{DSM\ max}$	10	mA	$t_{stg}$	-55 ÷ +150	°C

<sup>1)</sup>  $t_{amb} = \sim 25^\circ\text{C}$

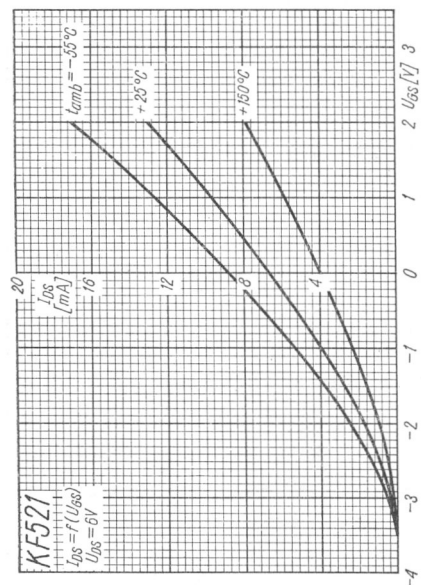
<sup>2)</sup>  $U_{GS} = -6\ \text{V}$



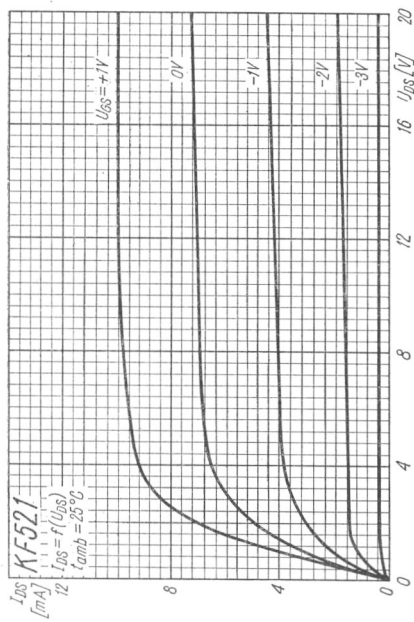
Rys. 1-790. Zależność maksymalnej mocy strat od temperatury otoczenia



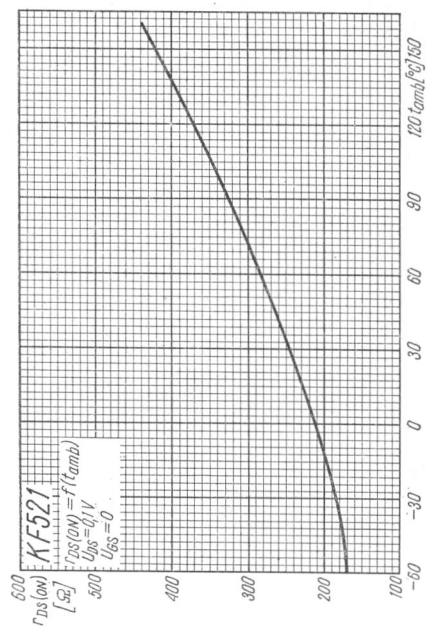
Rys. 1-791. Charakterystyki przejściowe



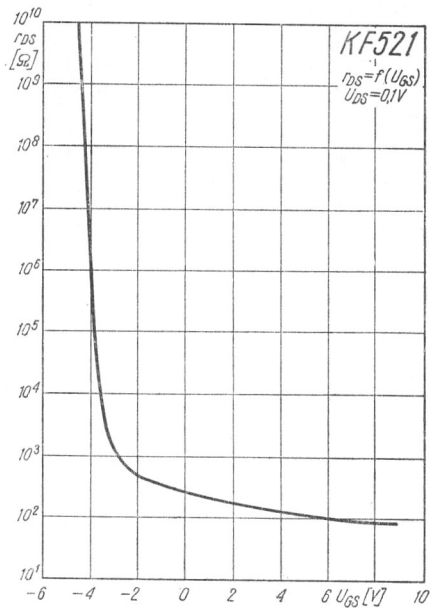
Rys. 1-792. Charakterystyki przejściowe



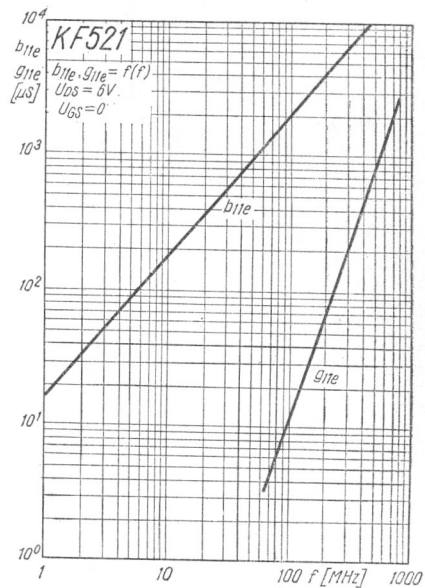
Rys. 1-793. Charakterystyki statyczne



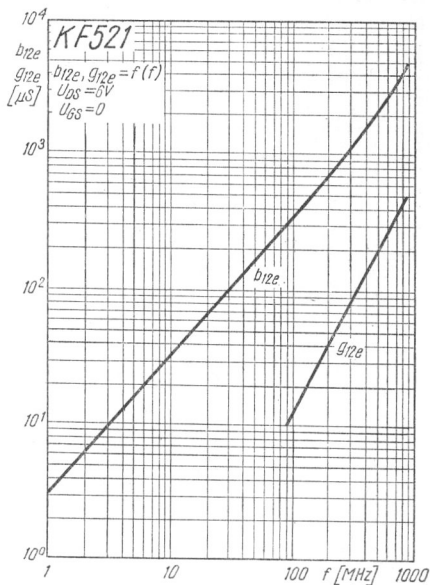
Rys. 1-794. Zależność rezystancji  $r_{DS}$  od temperatury otoczenia



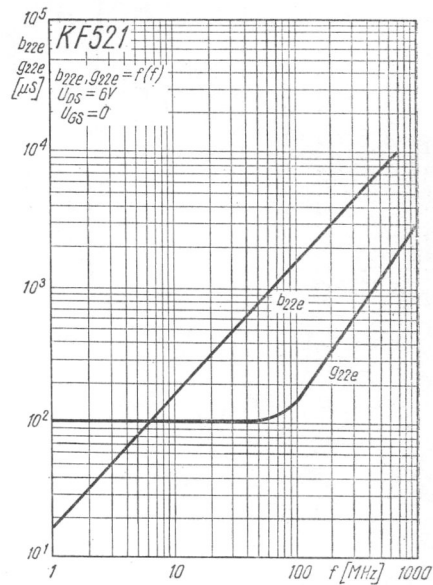
Rys. 1-795. Zależność rezystancji  $r_{DS}$  od napięcia bramki



Rys. 1-796. Zależność parametrów  $b_{11e}$  i  $g_{11e}$  od częstotliwości



Rys. 1-797. Zależność parametrów  $b_{12e}$  i  $g_{12e}$  od częstotliwości



Rys. 1-798. Zależność parametrów  $b_{22e}$  i  $g_{22e}$  od częstotliwości